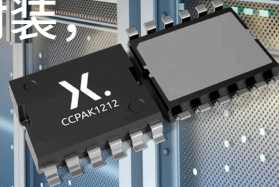


# Nexperia CCPAK MOSFET

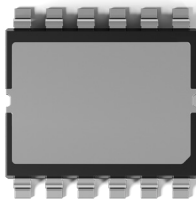
## 采用突破性JEDEC标准铜夹片封装，性能再上一层楼



Nexperia的JEDEC标准铜夹片CCPAK1212 MOSFET封装突破了性能和效率的上限。尺寸设计紧凑，仅12 mm×12 mm，可提供两种散热选项：CCPAK1212i采用反向顶部散热；CCPAK1212采用底部散热。这类封装的额定功率高达1.5 kW、电阻和热阻较低、电流密度高且SOA性能非常出色，可确保实现卓越的可靠性和效率，满足下一代工业应用的高功率需求。

### 特性和优势

- › 顶部散热和底部散热选项有助于增强散热性能。
- › 额定功率值高达1.5 kW，封装尺寸仅12 mm×12 mm。
- ›  $R_{DS(on)}$  非常低，因此导通损耗 $I^2R$ 较低。
- › 线型模式(SOA)性能优异，可实现冲击电流和浪涌电压保护。
- › 铜夹片技术实现了低电阻和低热阻。
- › 高性能硅晶圆。
- › 优秀的板级可靠性。



顶部散热  
CCPAK1212i



底部散热  
CCPAK1212

### 应用

- › 高功率BLDC电机控制应用
- › 高功率转换 (DC/DC和AC/DC)
- › 电池管理和保护
- › 住宅/商用热泵
- › 汽车和越野牵引
- › 通信基础设施 (热插拔)
- › 电池管理系统
- › 可再生能源



## 产品组合

CCPAK1212 MOSFET器件已加入我们知名的NextPower 80/100 V和ASFET热插拔产品组合。

### NextPower 80/100 V

产品名称	封装	V <sub>DS</sub> [最大值] (V)	R <sub>DS(on)</sub> [最大值] (VGS = 10 V (mΩ))	T <sub>J</sub> [最大值] (°C)	I <sub>b</sub> [最大值] (A)
PSMNR90-80CSF	CCPAK1212i (顶部散热)	80	0.9	175	505
PSMN1R1-80CSF			1.16	175	385
PSMN1R0-100CSF		100	1.04	175	460
PSMN1R4-100CSF			1.35	175	355
PSMNR90-80ASF	CCPAK1212 (底部散热)	80	0.85	175	505
PSMN1R1-80ASF			1.11	175	385
PSMN1R0-100ASF		100	0.99	175	460
PSMN1R3-100ASF			1.3	175	355

### 适用于热插拔和软启动的ASFET

产品名称	封装	V <sub>DS</sub> [最大值] (V)	R <sub>DS(on)</sub> [最大值] (VGS = 10 V (mΩ))	T <sub>J</sub> [最大值] (°C)	线性模式SOA 50 V 1 ms (A)
PSMN1R0-80CSE	CCPAK1212i (顶部散热)	80	0.95	175	80
PSMN1R2-80CSE			1.23	175	48
PSMN1R1-100CSE		100	1.09	175	80
PSMN1R4-100CSE			1.42	175	48
PSMNR90-80ASE	CCPAK1212 (底部散热)	80	0.9	175	85
PSMN1R2-80ASE			1.18	175	48
PSMN1R0-100ASE		100	1.04	175	85
PSMN1R4-100ASE			1.36	175	48



了解更多

如需产品数据表、应用和设计支持、参数数据、视频及最新新闻和博客等更多相关信息，请前往访问：

[nexperia.com/ccpak-mosfets](https://nexperia.com/ccpak-mosfets)

© 2024 Nexperia B.V.

保留所有权利。未经版权所有者优先书面同意，禁止复制本文全部或部分內容。本文档中所提供的信息不构成任何报价或合同的一部分，且被认为是准确可靠的，如有变更，恕不另行通知。对于使用本文档所产生的任何后果，出版方概不承担任何责任。出版內容既不传达也不暗示专利或者其他工业或知识产权下的任何许可。

发布日期：

2024年11月